

آزمایش شماره 12 (صفحه 26): بررسی مدار هدایت ترانزیستور

نام ونام خانوادگی دانشجو : رحمت اله انصاری

شماره دانشجویی : 9912377331 روز وساعت کلاس : چهارشنبه ساعت 16

تحلیل نظری آزمایش (0.5 نمره):

*درحالت خاموشی LED :

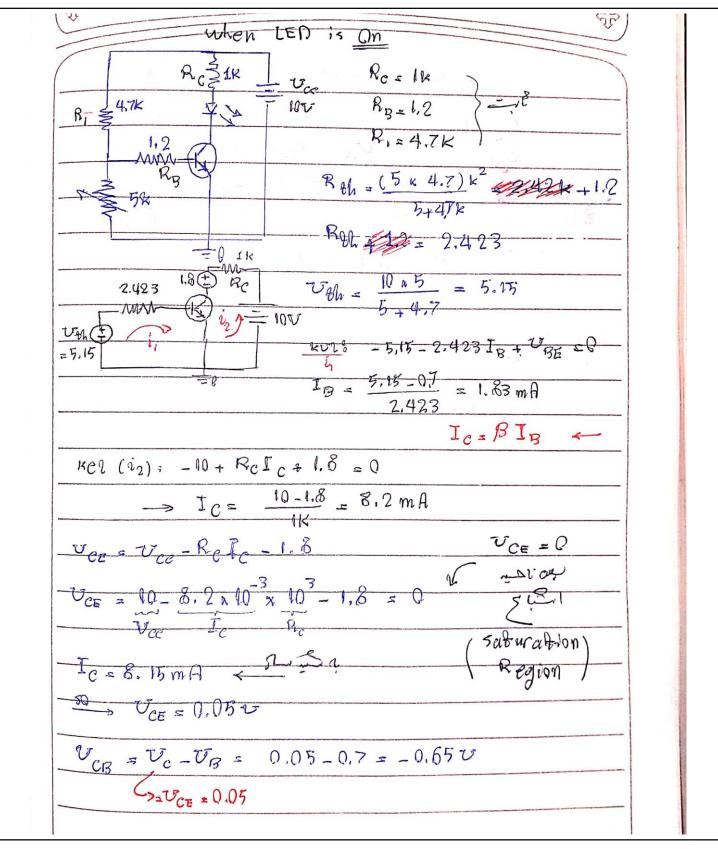
V _{ce}	V _{cb}	V_{be}	I _c	حالت ترانزيستور
10	9.4	0.6	0	قطع

*درحالت روشنایی کامل LED :

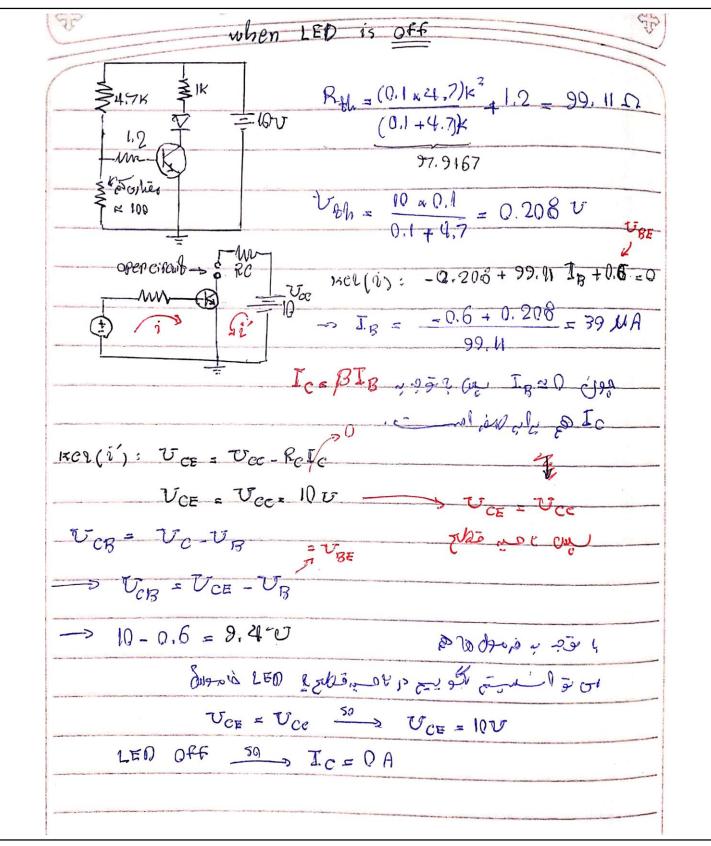
V_{ce}	V_{cb}	V_{be}	I _c	حالت ترانزيستور
0.05	-0.65	0.7	8.2m	اشباع

توضیحات دو صفحه پیش رو . . .



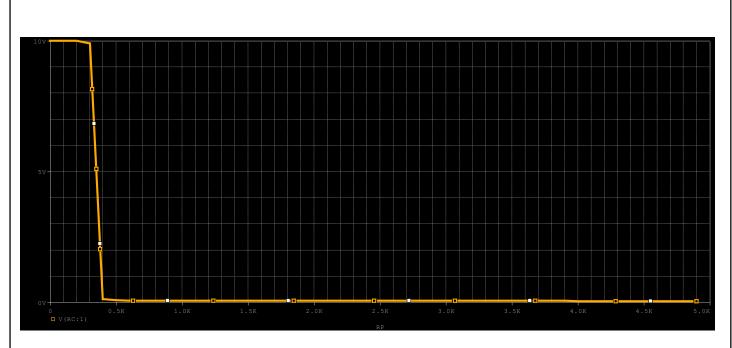




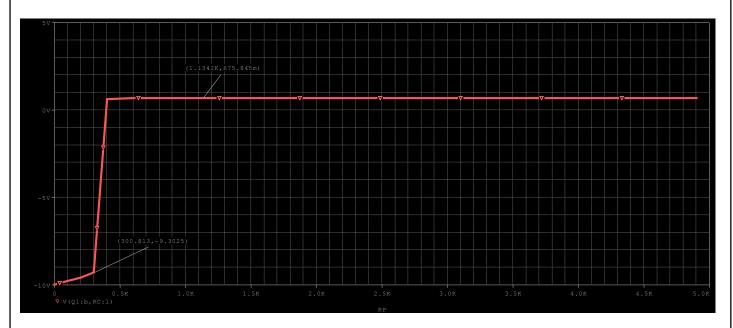




V-ce schematic

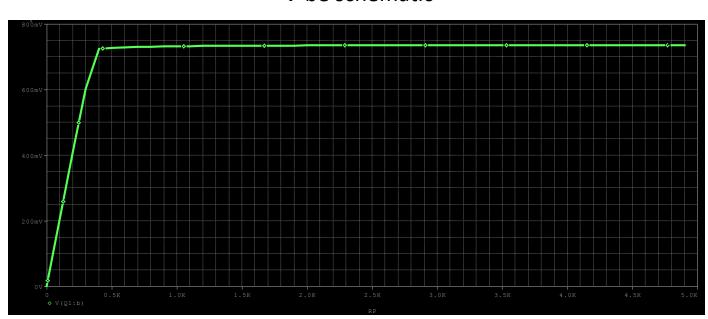


V-cb schematic

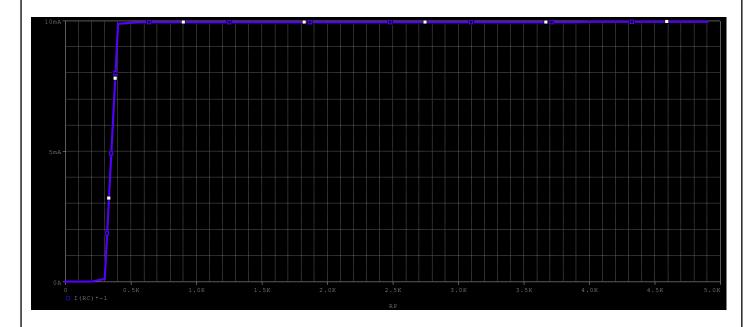




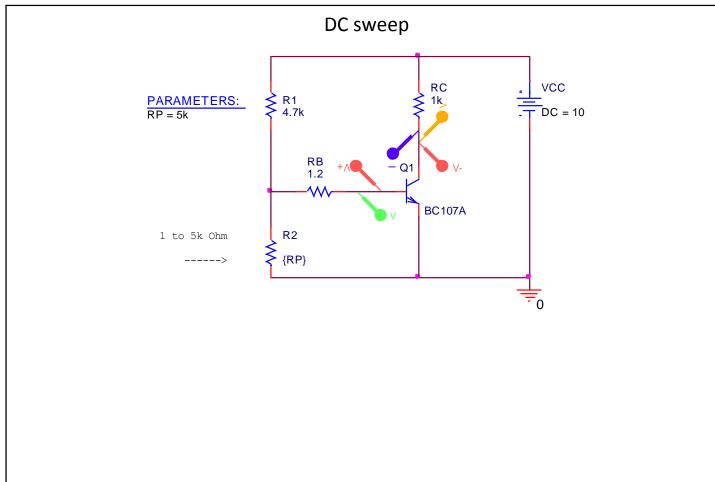




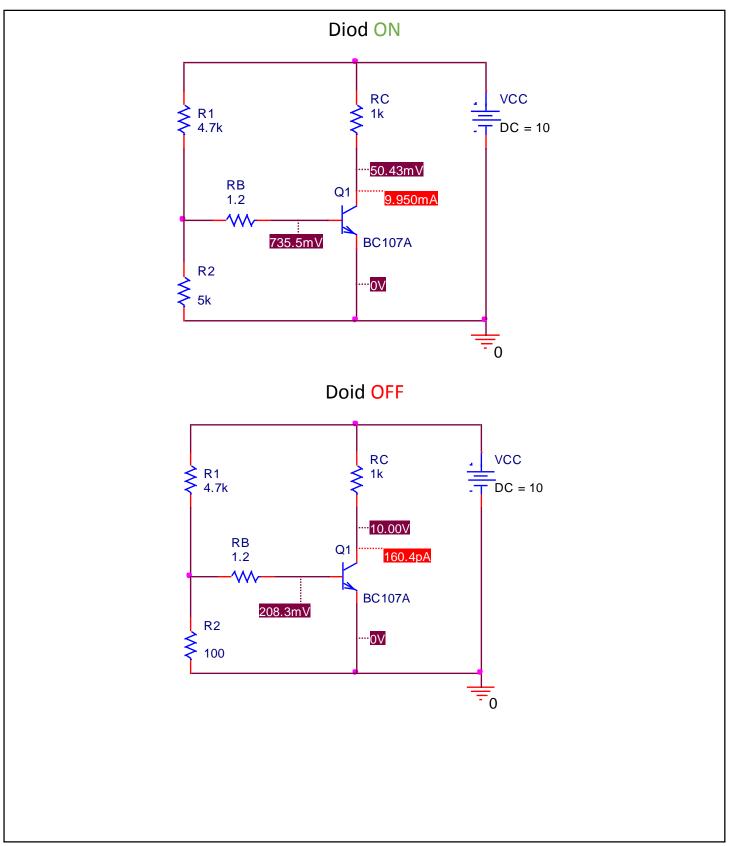
I-c schematic













تحلیل شبیه سازی (0.5 نمره):

*درحالت خاموشی LED : پی اس پایس

V _{ce}	V _{cb}	V _{be}	Ic	حالت ترانزيستور	
10	9.7917	0.2083	160.4pA	قطع	
			. 1	FD 1.15 .1.2	

*درحالت روشنایی کامل LED :

V_{ce}	V_{ce} V_{cb}		I _c	حالت ترانزيستور	
0.05043 -0.68507		0.7355	9.95mA	اشباع	

*درحالت خاموشی LED : پرتئوس

		Ic	حالت ترانزيستور
9.98 9.5	/ 1 () 41	. 0	قطع

*درحالت روشنایی کامل LED :

V _{ce}	V_{ce} V_{cb}		I _c	حالت ترانزيستور	
0.26	0.26 -0.63 0.89		7.52m	روشن	

*درصد خطا (PS-pise)

نوع تحليل	Diod	Transistor	V-ce	V-cb	V-be	I-c
	Status	Status				
نظری	Off	Cut	10	9.4	0.6	0
شبیه سازی	Off	Cut	10	9.7917	0.2083	160.4p
درصد خطا	-	-	0	4	65	-
نظرى	On	Sat	0.05	-0.65	0.7	8.2m
شبیه سازی	On	Sat	0.05043	-0.68507	0.7355	9.950m
درصد خطا	-	-	0.8	5.11	4.83	17.59



